
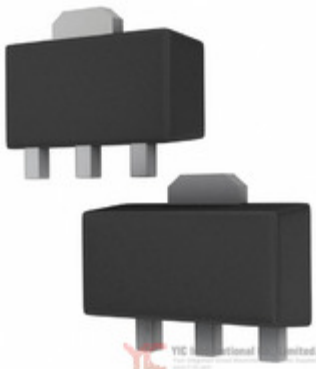
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>MT3S111P(TE12L,F)</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT3S111P(TE12L,F)</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N</p> <p>Datenblätter:  MT3S111P(TE12L,F).pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT3S111P(TE12L,F)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	6V
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	PW-MINI
Serie	-
Leistung - max	1W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-243AA
Andere Namen	MT3S111P(TE12LF)CT
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Rauschzahl (dB Typ @ f)	1.25dB @ 1GHz
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gewinnen	10.5dB
Frequenz - Übergang	8GHz
detaillierte Beschreibung	RF Transistor NPN 6V 100mA 8GHz 1W Surface Mount
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 30mA, 5V
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

MT3S111P(TE12L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT3S111P(TE12L,F)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT3S111P(TE12L,F) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MT3S111P(TE12L,F) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT3S111P TOSHIBA MT3S111P TOSHIBA</p>	 <p>MT3S111(TE85L,F) TOSHIBA TOSHIBA SOT23</p>	 <p>MT3S111(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N</p>	 <p>MT3S111TU(T5LT) TOSHIBA</p>
 <p>MT3S113(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N</p>	 <p>MT3S113P TOSHIBA MT3S113P TOSHIBA</p>	 <p>MT3S111(TE85L) TOSHIBA TOSHIBA SOT23</p>	 <p>MT3S111TU TOSHIBA MT3S111TU TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT3S111P(TE12L,F) Toshiba Semiconductor and Storage	MT3S111P(TE12L,F) Datenblatt	MT3S111P(TE12L,F)-Datenblätter	MT3S111P(TE12L,F) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage MT3S111P(TE12L,F)
MT3S111P(TE12L,F) Electronic	MT3S111P(TE12L,F)-Komponenten	MT3S111P(TE12L,F)-Verteiler	MT3S111P(TE12L,F)-Bild	MT3S111P(TE12L,F)-Teil
MT3S111P(TE12L,F) Preis	MT3S111P(TE12L,F) Hersteller	MT3S111P(TE12L,F) Bild	MT3S111P(TE12L,F) Aktie	MT3S111P(TE12L,F) Inventar
MT3S111P(TE12L,F) Neu	MT3S111P(TE12L,F) Original	MT3S111P(TE12L,F) garantiert	MT3S111P(TE12L,F) RFQ	MT3S111P(TE12L,F) Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited